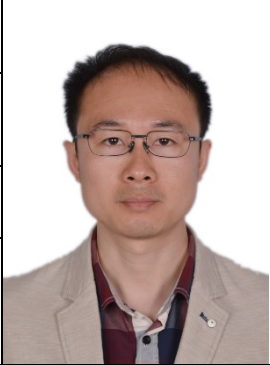


导师姓名	黄文奇	性 别	男	出生年月	1984, 6	
政治面貌	党员	专业技术职务	副高	行政职务	无	
所属学院	理学院	办公电话		个人邮箱	hwq5667@bistu.edu.cn	
任硕导时间	2017, 7			最后学历/学位	博士研究生	
专业学位	电子信息类	集成电路工程		主要研究方向	半导体光电材料和器件设计	
	研究方向	集成电路设计与测试			半导体材料高通量计算与机器学习	
个人简历 (从大学开始填起)	自何年月	至何年月	就学或工作单位 (填至专业或系部)			
	2008, 9	至今	北京信息科技大学 理学院 教师			
	2013, 9	2016, 7	中国科学院半导体研究所 微电子与固体电子学 博士			
	2005, 9	2008, 7	中国石油大学 (北京) 无线电物理 硕士			
	2001, 9	2005, 7	天津工业大学 电子信息科学与技术 本科			
目前承担科研课题 (限填 5 项, 含项目名称、来源, 本人排序)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 促进高校内涵发展-科研水平提高项目, 主持/第一, 16 万 2. 北京市青年拔尖人才培养计划项目, 主持/第一, 45 万 3. 国家自然科学基金青年项目, 主持/第一, 18 万 					
近五年主要学术成果 (限填 10 项, 包括代表性的论文、专著、专利、科技奖励等, 均标注排序)	<p>[1] Sun Shengliu, <u>Huang Wenqi</u>, Zhang Lixin, et al. Band and luminescence regulation of SiGeSn ternary alloy: A first-principles investigation[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 899: 163339. (SCI 二区, IF=4.71)</p> <p>[2] 孙生柳, <u>黄文奇</u>, 张立鑫, 等. 硅基IV族 SiGeSn 三元合金晶格结构、电子结构和光学性质的第一性原理[J]. 人工晶体学报, 2021, 50(12): 2232~2239. (北大中文核心期刊)</p> <p>[3] Zhang Lixin, Sun Shengliu, <u>Huang Wenqi</u>, et al. The Investigation of Lattice Properties for Group-IV SiGeSn Ternary Alloy: By Using Machine Learning Method[J]. Nano Hybrids and Composites. 2022, 34: 83-88.</p> <p>[4] Sun Shengliu, Zhang Lixin, <u>Huang Wenqi</u>, et al. First-Principal Investigation of Lattice Constants of Si_{1-x}Ge_x, Si_{1-x}Sn_x, and Ge_{1-x}Sn_x[J]. Nano Hybrids and Composites. 2022, 34: 77~82.</p>					

	<p>[5] <u>W. Huang</u>, H. Yang, B. Cheng, C. Xue, <i>Theoretical study of the bandgap regulation of a two-dimensional GeSn alloy under biaxial strain and uniaxial strain along armchair direction</i>, <i>Physical Chemistry Chemical Physics</i>, (2018). 23344-23351. (SCI 二区, IF=4.355)</p> <p>[6] <u>W. Huang</u>, H. Yang, B. Cheng, C. Xue, <i>Theoretical study of the band structure for multilayer germanane under external strain</i>, <i>Journal of Physics D: Applied Physics</i>, 51 (2018) 295101. (SCI 二区, IF=2.649)</p> <p>[7] <u>W. Huang</u>, H. Yang, B. Cheng, C. Xue, <i>Theoretical study of the effect of different n-doping elements on band structure and optical gain of GeSn alloys</i>, <i>Physical Chemistry Chemical Physics</i>, 19(2017)27031. (SCI 二区, IF=4.355)</p> <p>[8] <u>W. Huang</u>, B. Cheng, C. Xue, H. Yang, <i>The band structure and optical gain of a new IV-group alloy GePb: A first-principles calculation</i>, <i>Journal of Alloys and Compounds</i>, 701 (2017) 816-821. (SCI 二区, IF=3.049)</p> <p>[9] <u>W. Huang</u>, B. Cheng, C. Xue, Z. Liu, <i>Comparative studies of band structures for biaxial (100)-, (110)-, and (111)-strained GeSn: A first-principles calculation with GGA+U approach</i>, <i>Journal of Applied Physics</i>, 118 (2015) 165704. (SCI, IF=2.117)</p> <p>[10] <u>W. Huang</u>, B. Cheng, C. Xue, C. Li, <i>Comparative studies of clustering effect, electronic and optical properties for GePb and GeSn alloys with low Pb and Sn concentration</i>, <i>Physica B: condensed matter</i>, 443 (2014) 43-48. (SCI)</p>
其它	